



JAPAN PATENT OFFICE

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Data of Application: July 24, 2002

Application Number: JP2002-214900

[ST.10/C]:

Applicant(s): FUJITSU LIMITED

October 1, 2002

Commissioner, Japan Patent Office
S h i n - i c h i r o O t a

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月24日

出願番号

Application Number:

特願2002-214900

ST.10/C]:

[JP2002-214900]

出願人

Applicant(s):

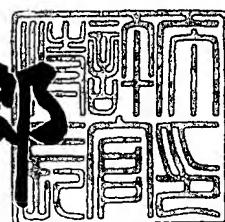
富士通株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2002年10月 1日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2002-3075770

【書類名】 特許願

【整理番号】 0250183

【提出日】 平成14年 7月24日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G11B 5/39

【発明の名称】 C P P 構造磁気抵抗効果素子

【請求項の数】 5

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通
株式会社内

【氏名】 長坂 恵一

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通
株式会社内

【氏名】 清水 豊

【特許出願人】

【識別番号】 000005223

【氏名又は名称】 富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】 100105094

【弁理士】

【氏名又は名称】 山▲崎▼ 薫

【電話番号】 03-5226-0508

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 049618

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9803088

【プルーフの要否】 要

【書類名】明細書

【発明の名称】C P P 構造磁気抵抗効果素子

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 導電性の自由側磁性層と、導電性の固定側磁性層と、自由側磁性層および固定側磁性層の間に挟まれる導電性の非磁性中間層と、導電性材料から構成される主電極層と、導電性材料で構成され、自由側磁性層および主電極層の間に挟まれる狭小電極層と、絶縁性磁性材料で構成され、狭小電極層に隣接しつつ自由側磁性層および主電極層の間に挟まれる磁区制御膜とを備えることを特徴とするC P P 構造磁気抵抗効果素子。

【請求項 2】 請求項 1 に記載のC P P 構造磁気抵抗効果素子において、前記磁区制御膜はヘッドスライダの空気軸受け面との間に前記狭小電極層を挟み込むことを特徴とするC P P 構造磁気抵抗効果素子。

【請求項 3】 請求項 1 に記載のC P P 構造磁気抵抗効果素子において、前記磁区制御膜には、ヘッドスライダの空気軸受け面に隣接して前記狭小電極層を挟み込む 1 対の第 1 領域と、空気軸受け面との間に狭小電極層および第 1 領域を挟み込む第 2 領域とが規定されることを特徴とするC P P 構造磁気抵抗効果素子。

【請求項 4】 請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載のC P P 構造磁気抵抗効果素子において、前記磁区制御膜は反強磁性膜であることを特徴とするC P P 構造磁気抵抗効果素子。

【請求項 5】 導電性の自由側磁性層と、導電性の固定側磁性層と、自由側磁性層および固定側磁性層の間に挟まれる導電性の非磁性中間層と、導電性材料から構成される主電極層と、導電性材料で構成され、自由側磁性層および主電極層の間に挟まれる狭小電極層と、磁性材料で構成され、狭小電極層に隣接しつつ自由側磁性層に接触する磁区制御膜と、絶縁性材料で構成され、磁区制御膜および主電極層の間に挟まれる絶縁層とを備えることを特徴とするC P P 構造磁気抵抗効果素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、任意の基準面に積層される磁気抵抗効果膜に、基準面に直交する垂直方向に沿ってセンス電流を流通させるCPP (Current Perpendicular to the Plane) 構造磁気抵抗効果素子に関し、特に、導電性の自由側磁性層 (free layer) と、導電性の固定側磁性層 (pinned layer) と、自由側磁性層および固定側磁性層の間に挟まれる導電性の非磁性中間層とを備えるCPP構造磁気抵抗効果素子に関する。

【0002】

【従来の技術】

いわゆるスピナルブ膜を備えるCPP構造磁気抵抗効果素子は広く知られる。こういったCPP構造磁気抵抗効果素子では、外部磁界の作用に応じてスピナルブ膜中の自由側強磁性層で磁化方向は回転する。このとき、自由側強磁性層では予め磁化方向は一方向に揃えられることが望まれる。こういった磁化方向の設定にあたって1対の磁区制御膜は用いられる。磁区制御膜は基準面に沿って磁気抵抗効果膜を挟み込む。磁区制御膜同士の間に形成されるバイアス磁界に自由側強磁性層は曝される。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

自由側強磁性層では、磁区制御膜から離れるに従ってバイアス磁界の強度は弱まる。磁界の強度が弱まれば、磁化方向の統一すなわち单磁区化は阻害される。さらにスピナルブ膜が微細化されていかない限り、十分な強度のバイアス磁界を確保することは難しい。しかも、前述のような磁区制御膜では製造過程で形状精度の確保が難しい。バイアス磁界の強度は磁区制御膜の形状精度に影響されやすい。安定したバイアス磁界はなかなか得られない。

【0004】

一般に、スピナルブ膜は導電性の材料から構成される。スピナルブ膜ではほぼ全域にわたってセンス電流は流通する。その結果、さらにスピナルブ膜が微細化されない限り、センス電流の流通路は狭められることはできない。センス電流の流通路が狭められれば、CPP構造磁気抵抗効果素子の感度は高められる

。同時に、センス電流の流通路の狭小化に基づきCPP構造磁気抵抗効果素子の実効コア幅は狭められる。磁気情報の読み出しにあたってCPP構造磁気抵抗効果素子の解像度は高められる。

【0005】

本発明は、上記実状に鑑みてなされたもので、一層の微細化を伴わずに十分に自由側磁性層の単磁区化を実現することができるCPP構造磁気抵抗効果素子を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、第1発明によれば、導電性の自由側磁性層と、導電性の固定側磁性層と、自由側磁性層および固定側磁性層の間に挟まれる導電性の非磁性中間層と、導電性材料から構成される主電極層と、導電性材料で構成され、自由側磁性層および主電極層の間に挟まれる狭小電極層と、絶縁性磁性材料で構成され、狭小電極層に隣接しつつ自由側磁性層および主電極層の間に挟まれる磁区制御膜とを備えることを特徴とするCPP構造磁気抵抗効果素子が提供される。

【0007】

また、第2発明によれば、導電性の自由側磁性層と、導電性の固定側磁性層と、自由側磁性層および固定側磁性層の間に挟まれる導電性の非磁性中間層と、導電性材料から構成される主電極層と、導電性材料で構成され、自由側磁性層および主電極層の間に挟まれる狭小電極層と、磁性材料で構成され、狭小電極層に隣接しつつ自由側磁性層に接触する磁区制御膜と、絶縁性材料で構成され、磁区制御膜および主電極層の間に挟まれる絶縁層とを備えることを特徴とするCPP構造磁気抵抗効果素子が提供される。

【0008】

こういったCPP構造磁気抵抗効果素子では、磁区制御膜および自由側磁性層の交換結合に基づき自由側磁性層の磁化方向は1方向に揃えられる。こうした交換結合によれば、1対の磁区制御ハード膜の間で静磁界すなわちバイアス磁界が形成される場合に比べて確実に自由側磁性層の単磁区化は実現されることができ

る。しかも、自由側磁性層は必ずしも微細化される必要はない。

【0009】

加えて、自由側磁性層と主電極層との間では狭小電極層のみで電気的接続は確立される。こういった狭小電極層の働きで、自由側磁性層や固定側磁性層を流通する電流の流通路は狭められることができる。単位断面積当たりの電流量は増加する。したがって、CPP構造磁気抵抗効果素子の読み取り感度は高められることができる。同時に、電流の流通路の狭小化に基づきCPP構造磁気抵抗効果素子の実効コア幅は狭められる。磁気情報の読み出しにあたってCPP構造磁気抵抗効果素子の解像度は高められることができる。

【0010】

磁区制御膜はヘッドスライダの空気軸受け面との間に狭小電極層を挟み込んでよい。その他、磁区制御膜には、ヘッドスライダの空気軸受け面に隣接して狭小電極層を挟み込む1対の第1領域と、空気軸受け面との間に狭小電極層および第1領域を挟み込む第2領域とが規定されてもよい。いずれの場合でも、狭小電極層はヘッドスライダの空気軸受け面に沿って配置されることができる。電流は空気軸受け面に向かって誘導される。したがって、CPP構造磁気抵抗効果素子の読み取り感度は確実に高められることができる。しかも、磁区制御膜は大きな接触面積で自由側磁性層に接触することができる。

【0011】

以上のようなCPP構造磁気抵抗効果素子は、例えばハードディスク駆動装置(HDD)といった磁気ディスク駆動装置に組み込まれるヘッドスライダに搭載されてもよく、磁気テープ駆動装置といったその他の磁気記録媒体駆動装置に組み込まれるヘッドスライダに搭載されてもよい。

【0012】

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照しつつ本発明の一実施形態を説明する。

【0013】

図1は磁気記録媒体駆動装置の一具体例すなわちハードディスク駆動装置(HDD)11の内部構造を概略的に示す。このHDD11は、例えば平たい直方体

の内部空間を区画する箱形の筐体本体12を備える。収容空間には、記録媒体としての1枚以上の磁気ディスク13が収容される。磁気ディスク13はスピンドルモータ14の回転軸に装着される。スピンドルモータ14は、例えば7200 rpmや10000 rpmといった高速度で磁気ディスク13を回転させることができる。筐体本体12には、筐体本体12との間で収容空間を密閉する蓋体すなわちカバー（図示されず）が結合される。

【0014】

収容空間には、垂直方向に延びる支軸15回りで揺動するキャリッジ16がさらに収容される。このキャリッジ16は、支軸15から水平方向に延びる剛体の揺動アーム17と、この揺動アーム17の先端に取り付けられて揺動アーム17から前方に延びる弾性サスペンション18とを備える。周知の通り、弾性サスペンション18の先端では、いわゆるジンバルばね（図示されず）の働きで浮上ヘッドスライダ19は片持ち支持される。浮上ヘッドスライダ19には、磁気ディスク13の表面に向かって弾性サスペンション18から押し付け力が作用する。磁気ディスク13の回転に基づき磁気ディスク13の表面で生成される気流の働きで浮上ヘッドスライダ19には浮力が作用する。弾性サスペンション18の押し付け力と浮力とのバランスで磁気ディスク13の回転中に比較的に高い剛性で浮上ヘッドスライダ19は浮上し続けることができる。

【0015】

こうした浮上ヘッドスライダ19の浮上中に、キャリッジ16が支軸15回りで揺動すると、浮上ヘッドスライダ19は半径方向に磁気ディスク13の表面を横切ることができる。こうした移動に基づき浮上ヘッドスライダ19は磁気ディスク13上の所望の記録トラックに位置決めされる。このとき、キャリッジ16の揺動は例えばボイスコイルモータ（VCM）といった動力源21の働きを通じて実現されればよい。周知の通り、複数枚の磁気ディスク13が筐体本体12内に組み込まれる場合には、隣接する磁気ディスク13同士の間に2つの弾性サスペンション18が配置される。

【0016】

図2は浮上ヘッドスライダ19の一具体例を示す。この浮上ヘッドスライダ1

9は、平たい直方体に形成される Al_2O_3 -TiC(アルチック)製のスライダ本体22と、このスライダ本体22の空気流出端に接合されて、読み出し書き込みヘッド23を内蔵する Al_2O_3 (アルミナ)製のヘッド素子内蔵膜24とを備える。スライダ本体22およびヘッド素子内蔵膜24には、磁気ディスク13に対向する媒体対向面すなわち浮上面25が規定される。磁気ディスク13の回転に基づき生成される気流26は浮上面25に受け止められる。

【0017】

浮上面25には、空気流入端から空気流出端に向かって延びる2筋のレール27が形成される。各レール27の頂上面にはいわゆるABS(空気軸受け面)28が規定される。ABS28では気流26の働きに応じて前述の浮力が生成される。ヘッド素子内蔵膜24に埋め込まれた読み出し書き込みヘッド23は、後述されるように、ABS28で前端を露出させる。ただし、ABS28の表面には、読み出し書き込みヘッド23の前端に覆い被さる DLC(ダイヤモンドライカーボン)保護膜が形成されてもよい。なお、浮上ヘッドスライダ19の形態はこういった形態に限られるものではない。

【0018】

図3は浮上面25の様子を詳細に示す。読み出し書き込みヘッド23は、薄膜磁気ヘッドすなわち誘導書き込みヘッド素子31とCPP構造電磁変換素子すなわちCPP構造磁気抵抗効果(MR)読み取り素子32とを備える。誘導書き込みヘッド素子31は、周知の通り、例えば導電コイルパターン(図示されず)で生起される磁界を利用して磁気ディスク13に2値情報を書き込むことができる。CPP構造MR読み取り素子32は、周知の通り、磁気ディスク13から作用する磁界に応じて変化する抵抗に基づき2値情報を検出することができる。誘導書き込みヘッド素子31およびCPP構造MR読み取り素子32は、前述のヘッド素子内蔵膜24の上側半層すなわちオーバーコート膜を構成する Al_2O_3 (アルミナ)膜33と、下側半層すなわちアンダーコート膜を構成する Al_2O_3 (アルミナ)膜34との間に挟み込まれる。

【0019】

誘導書き込みヘッド素子31は、ABS28で前端を露出させる上部磁極層3

5と、同様にA B S 2 8で前端を露出させる下部磁極層3 6とを備える。上部および下部磁極層3 5、3 6は例えばFe NやNi Feから形成されればよい。上部および下部磁極層3 5、3 6は協働して誘導書き込みヘッド素子3 1の磁性コアを構成する。

【0020】

上部および下部磁極層3 5、3 6の間には例えばAl₂O₃（アルミナ）製の非磁性ギャップ層3 7が挟み込まれる。周知の通り、導電コイルパターンで磁界が生起されると、非磁性ギャップ層3 7の働きで、上部磁極層3 5と下部磁極層3 6とを行き交う磁束は浮上面2 5から漏れ出る。こうして漏れ出る磁束が記録磁界（ギャップ磁界）を形成する。

【0021】

CPP構造MR読み取り素子3 2は、アルミナ膜3 4すなわち下地絶縁層の表面に沿って広がる下側電極3 8を備える。この下側電極3 8には、引き出し導電層3 8 aと、引き出し導電層3 8 aの表面から立ち上がる導電端子片3 8 bとが形成される。下側電極3 8は導電性を備えるだけでなく同時に軟磁性を備えてもよい。下側電極3 8が例えばNi Feといった導電性の軟磁性体で構成されると、この下側電極3 8は同時にCPP構造MR読み取り素子3 2の下部シールド層として機能することができる。

【0022】

下側電極3 8は、アルミナ膜3 4の表面で広がる絶縁層4 1に埋め込まれる。この絶縁層4 1は、導電端子片3 8 bの壁面に接しつつ引き出し導電層3 8 aの表面に沿って広がる。ここで、導電端子片3 8 bおよび絶縁層4 1は所定の基礎層を構成する。導電端子片3 8 bの頂上面および絶縁層4 1の表面は、基礎層上で切れ目なく連続する1平坦化面4 2すなわち基準面を規定する。

【0023】

平坦化面4 2上には磁気抵抗効果（MR）膜すなわちスピナルブ膜4 3が積層される。このスピナルブ膜4 3は、A B S 2 8で露出する前端から平坦化面4 2に沿って後方に広がる。このスピナルブ膜4 3は少なくとも導電端子片3 8 bの頂上面に横たわる。導電端子片3 8 bは、少なくともA B S 2 8で露出す

る前端でスピナルブ膜43の底面すなわち下側境界面に接触する。こうしてスピナルブ膜43と下側電極38との間には電気的接続が確立される。スピナルブ膜43の構造の詳細は後述される。

【0024】

平坦化面42上には被覆絶縁膜44が覆い被さる。被覆絶縁膜44上には上側電極45が配置される。この上側電極45は、導電性材料で構成され、被覆絶縁膜44の表面に沿って広がる引き出し導電層すなわち主電極層45aと、同様に導電性材料で構成され、スピナルブ膜43の頂上面すなわち上側境界面および主電極層45aの間に挟まれる狭小電極層45bとを備える。狭小電極層45bは少なくともABS28に沿ってスピナルブ膜43に接触する。こうしてスピナルブ膜43と上側電極45との間には電気的接続が確立される。

【0025】

こういった上側電極45は例えばNiFeといった導電性の軟磁性体で構成されればよい。上側電極45で導電性だけでなく同時に軟磁性が確立されれば、上側電極45は同時にCPP構造MR読み取り素子32の上部シールド層として機能することができる。前述の下部シールド層すなわち下側電極38と上側電極45との間隔は磁気ディスク13上で記録トラックの線方向に磁気記録の分解能を決定する。

【0026】

このCPP構造MR読み取り素子32では、狭小電極層45bに隣接しつつスピナルブ膜43と上側電極45の主電極層45aとの間に磁区制御膜46が挟まれる。磁区制御膜46は硬磁性膜（いわゆるハード膜）から構成されてもよく反強磁性膜から構成されてもよい。いずれの場合にも、磁区制御膜46には絶縁性が与えられる。絶縁性の反強磁性材料には例えばNiOやFe₂O₃が挙げられることがある。磁区制御膜46の詳細は後述される。

【0027】

図4に示されるように、スピナルブ膜43では、下地層51、磁化方向拘束層（pinning layer）すなわち反強磁性層52、固定側磁性層（pinning layer）53、非磁性中間層54および自由側磁性層（free

e layer) 55 が順番に重ね合わせられる。反強磁性層 52 の働きに応じて固定側磁性層 53 の磁化は 1 方向に固定される。ここで、下地層 51 は例えば Ta といった導電性材料から構成されればよい。反強磁性層 52 は例えば IrMn や PdPtMn といった反強磁性合金材料から形成されればよい。固定側磁性層 53 は例えば CoFe といった導電性の強磁性材料から形成されればよい。非磁性中間層 54 は例えば Cu といった導電性の非磁性材料から構成されればよい。自由側磁性層 55 は導電性の磁性材料から構成されればよい。自由側磁性層 55 には軟磁性層と強磁性層との積層体が用いられてもよい。

【0028】

磁区制御膜 46 には、ABS28 に隣接して上側電極 45 の狭小電極層 45b を挟み込む 1 対の第 1 領域 46a と、ABS28 との間に狭小電極層 45b および第 1 領域 46a を挟み込む第 2 領域 46b とが区画される。磁区制御膜 46 は第 1 および第 2 領域 46a、46b の全域で自由側磁性層 55 の表面に受け止められる。こうして磁区制御膜 46 および自由側磁性層 55 の間には磁気的な交換結合が確立される。この交換結合の働きで自由側磁性層 55 内の磁化方向 Mg は 1 方向に揃えられる。いわゆる単磁区化は実現される。

【0029】

磁気情報の読み出しにあたって CPP 構造 MR 読み取り素子 32 が磁気ディスク 13 の表面に向き合わせられると、スピナバルブ膜 43 では、周知の通り、磁気ディスク 13 から作用する磁界の向きに応じて自由側磁性層 55 の磁化方向は回転する。こうして自由側磁性層 55 の磁化方向が回転すると、スピナバルブ膜 43 の電気抵抗は大きく変化する。したがって、上側電極 45 および下側電極 38 からスピナバルブ膜 43 にセンス電流が供給されると、上側電極 45 および下側電極 38 から取り出される電気信号のレベルは電気抵抗の変化に応じて変化する。このレベルの変化に応じて 2 値情報は読み取ることができる。

【0030】

このとき、スピナバルブ膜 43 では上側電極 45 の狭小電極層 45b および下側電極 38 の導電端子片 38b の働きでセンス電流の流通路は狭められる。単位断面積当たりの電流量は増加する。したがって、CPP 構造 MR 読み取り素子 3

2の読み取り感度は高められる。同時に、センス電流の流通路の狭小化に基づきC P P構造M R読み取り素子3 2の実効コア幅は狭められる。磁気情報の読み出しにあたってC P P構造M R読み取り素子3 2の解像度は高められる。

【0031】

以上のようなC P P構造M R読み取り素子3 2では、磁区制御膜4 6および自由側磁性層5 5の交換結合に基づき自由側磁性層5 5の磁化方向M gは1方向に揃えられる。こうした交換結合によれば、1対の磁区制御ハード膜の間で静磁界すなわちバイアス磁界が形成される場合に比べて確実に自由側磁性層5 5の単磁区化は実現されることができる。しかも、スピナルブ膜4 3は必ずしも微細化される必要はない。

【0032】

次にC P P構造M R読み取り素子3 2の製造方法を簡単に説明する。周知通りに、ウェハー上では、例えばT a層、任意の反強磁性層、導電性強磁性層、導電性非磁性層、導電性強磁性層、絶縁性反強磁性層が順番に積層される。こうした積層には例えばスパッタリングが用いられればよい。T a層、任意の反強磁性層、導電性強磁性層、導電性非磁性層、導電性強磁性層、絶縁性反強磁性層は例えば真空環境下で連続的に成膜される。T a層、任意の反強磁性層、導電性強磁性層、導電性非磁性層、導電性強磁性層、絶縁性反強磁性層はウェハーの全面に形成されればよい。

【0033】

絶縁性反強磁性層の表面には所定の形状でレジスト膜が形成される。レジスト膜は各スピナルブ膜4 3の形状を象る。例えばイオンミリングが実施されると、レジスト膜下でウェハー上には規定の形状のスピナルブ膜4 3および絶縁性反強磁性層が残存する。その後、図5に示されるように、スピナルブ膜4 3および絶縁性反強磁性層6 1の周囲には被覆絶縁膜4 4が形成される。

【0034】

絶縁性反強磁性層6 1および被覆絶縁膜4 4の表面にはレジスト膜6 2が形成される。このレジスト膜6 2には狭小電極層4 5 bの形状を象った空隙6 3が規定される。この空隙6 3では絶縁性反強磁性層6 1の表面の一部が露出する。例

えばイオンミリングが実施されると、空隙63内で絶縁性反強磁性層61は削り取られる。こうして絶縁性反強磁性層61には、図6に示されるように、貫通孔64が形成される。その後、ウェハー上では上側電極45が形成される。上側電極45は部分的に貫通孔64に進入する。こうして上側電極45の狭小電極層45bは形成される。

【0035】

なお、前述の磁区制御膜46には絶縁性磁性材料に代えて導電性磁性材料が用いられてもよい。この場合には、図7から明らかなように、磁区制御膜46の表面に絶縁層65が積層形成される。この絶縁層65は非磁性層であってもよく硬磁性層や反強磁性層といった磁性層であってもよい。絶縁層65には、磁区制御膜46と同様に、ABS28に隣接して上側電極45の狭小電極層45bを挟み込む1対の第1領域65aと、ABS28との間に狭小電極層45bおよび第1領域65aを挟み込む第2領域65bとが区画される。したがって、センス電流は、狭小電極層45bおよび導電端子片38bの働きで確立される幅狭な流通路に沿って流通する。

【0036】

また、前述の磁区制御膜46は、例えば図8に示されるように、自由側磁性層55上でABS28に沿って狭小電極層45bを挟み込む1対の第1領域46aだけで構成されてもよい。さらに、磁区制御膜46は、例えば図9に示されるように、自由側磁性層55上でABS28との間に狭小電極層45bを挟み込む第2領域46bだけで構成されてもよい。いずれの場合でも、磁区制御膜46と自由側磁性層55との間で確立される交換結合に基づき自由側磁性層55の磁化方向Mgは1方向に揃えられる。自由側磁性層55の単磁区化は確実に実現することができる。しかも、スピナルブ膜43では、前述と同様に、センス電流の流通路は狭められることができる。CPP構造MR読み取り素子32の読み取り感度は高められる。同時に、センス電流の流通路の狭小化に基づきCPP構造MR読み取り素子32の実効コア幅は狭められる。

【0037】

その他、CPP構造MR読み取り素子32に組み込まれるスピナルブ膜43

では、前述のような逆積層構造に代えて順積層構造が採用されてもよい。この場合には、例えば図10に示されるように、下側電極38の引き出し導電層38a上に磁区制御膜46、自由側磁性層55、非磁性中間層54、固定側磁性層53および反強磁性層52が順番に積層される。下側電極38と自由側磁性層55との間には狭小電極層66が挟み込まれる。こうして下側電極38とスピナルブルブ膜43とは狭小電極層66のみで電気的に接続される。磁区制御膜46および自由側磁性層55の交換結合に基づき自由側磁性層55の磁化方向Mgは1方向に揃えられる。しかも、狭小電極層66の働きでセンス電流の流通路は狭められることができる。

【0038】

(付記1) 導電性の自由側磁性層と、導電性の固定側磁性層と、自由側磁性層および固定側磁性層の間に挟まれる導電性の非磁性中間層と、導電性材料から構成される主電極層と、導電性材料で構成され、自由側磁性層および主電極層の間に挟まれる狭小電極層と、絶縁性磁性材料で構成され、狭小電極層に隣接しつつ自由側磁性層および主電極層の間に挟まれる磁区制御膜とを備えることを特徴とするCPP構造磁気抵抗効果素子。

【0039】

(付記2) 付記1に記載のCPP構造磁気抵抗効果素子において、前記磁区制御膜はヘッドスライダの空気軸受け面との間に前記狭小電極層を挟み込むことを特徴とするCPP構造磁気抵抗効果素子。

【0040】

(付記3) 付記1に記載のCPP構造磁気抵抗効果素子において、前記磁区制御膜には、ヘッドスライダの空気軸受け面に隣接して前記狭小電極層を挟み込む1対の第1領域と、空気軸受け面との間に狭小電極層および第1領域を挟み込む第2領域とが規定されることを特徴とするCPP構造磁気抵抗効果素子。

【0041】

(付記4) 付記1～3のいずれかに記載のCPP構造磁気抵抗効果素子において、前記磁区制御膜は反強磁性膜であることを特徴とするCPP構造磁気抵抗効果素子。

【0042】

(付記5) 導電性の自由側磁性層と、導電性の固定側磁性層と、自由側磁性層および固定側磁性層の間に挟まれる導電性の非磁性中間層と、導電性材料から構成される主電極層と、導電性材料で構成され、自由側磁性層および主電極層の間に挟まれる狭小電極層と、磁性材料で構成され、狭小電極層に隣接しつつ自由側磁性層に接触する磁区制御膜と、絶縁性材料で構成され、磁区制御膜および主電極層の間に挟まれる絶縁層とを備えることを特徴とするC P P構造磁気抵抗効果素子。

【0043】

(付記6) 付記5に記載のC P P構造磁気抵抗効果素子において、前記磁区制御膜はヘッドスライダの空気軸受け面との間に前記狭小電極層を挟み込むことを特徴とするC P P構造磁気抵抗効果素子。

【0044】

(付記7) 付記5に記載のC P P構造磁気抵抗効果素子において、前記磁区制御膜には、ヘッドスライダの空気軸受け面に隣接して前記狭小電極層を挟み込む1対の第1領域と、空気軸受け面との間に狭小電極層および第1領域を挟み込む第2領域とが規定されることを特徴とするC P P構造磁気抵抗効果素子。

【0045】

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、一層の微細化を伴わずに十分に自由側磁性層の单磁区化は実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 ハードディスク駆動装置(HDD)の内部構造を概略的に示す平面図である。

【図2】 一具体例に係る浮上ヘッドスライダの構造を概略的に示す拡大斜視図である。

【図3】 浮上面で観察される読み出し書き込みヘッドの様子を概略的に示す正面図である。

【図4】 本発明の一実施形態に係るC P P構造磁気抵抗効果(MR)読み

取り素子の構造を概略的に示す拡大斜視図である。

【図5】 磁区制御膜の形成過程を概略滴に示すウェハーの垂直部分断面図である。

【図6】 磁区制御膜の形成過程を概略滴に示すウェハーの垂直部分断面図である。

【図7】 図4に対応し、一変形例に係る磁区制御膜の構造を概略的に示すCPP構造MR読み取り素子の拡大斜視図である。

【図8】 図4に対応し、他の変形例に係る磁区制御膜の構造を概略的に示すCPP構造MR読み取り素子の拡大斜視図である。

【図9】 図4に対応し、さらに他の変形例に係る磁区制御膜の構造を概略的に示すCPP構造MR読み取り素子の拡大斜視図である。

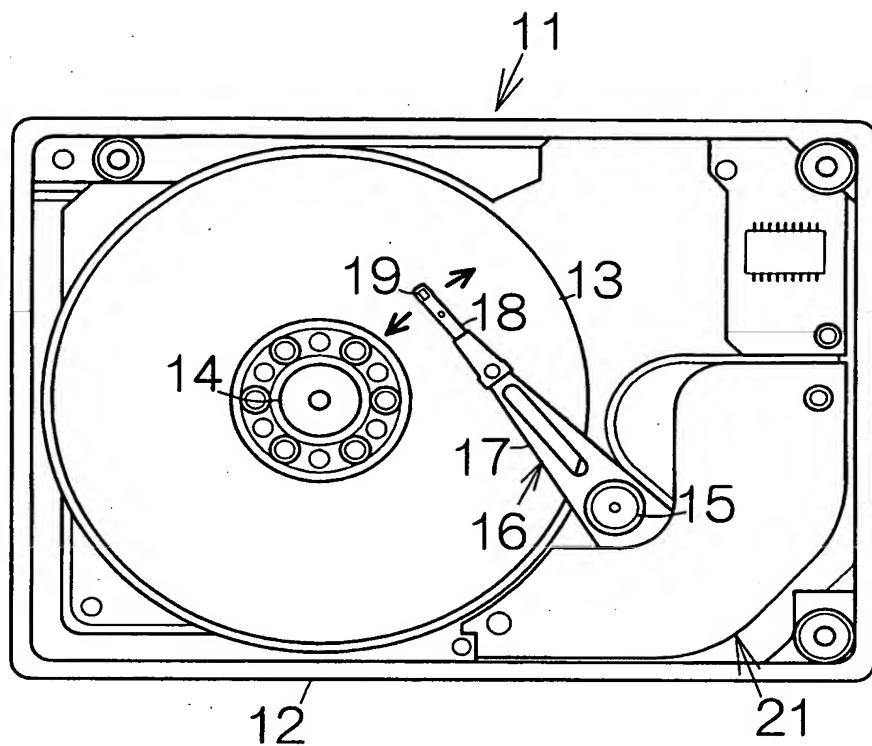
【図10】 図4に対応し、一変形例に係るスピナルブ膜の構造を概略的に示すCPP構造MR読み取り素子の拡大斜視図である。

【符号の説明】

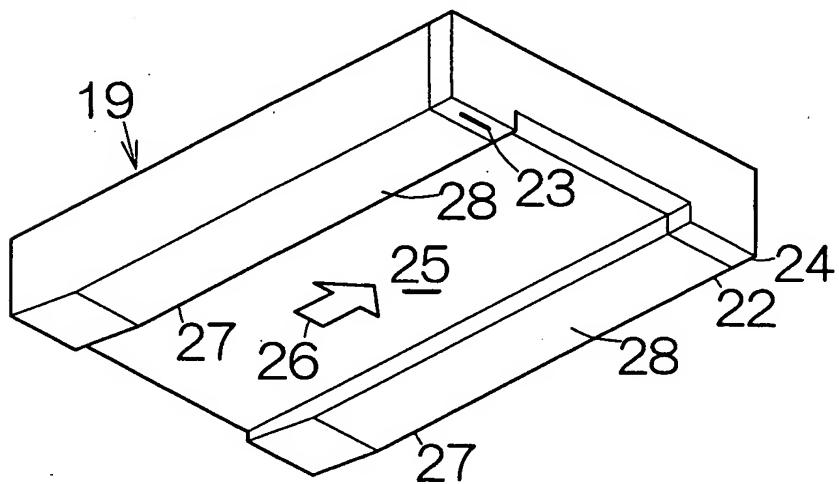
19 ヘッドスライダ、28 空気軸受け面 (A B S) 、32 CPP構造磁気抵抗効果 (MR) 素子、45a 主電極層、45b 狹小電極層、46 磁区制御膜、46a 第1領域、46b 第2領域、53 固定側磁性層、54 非磁性中間層、55 自由側磁性層、65 絶縁層。

【書類名】 図面

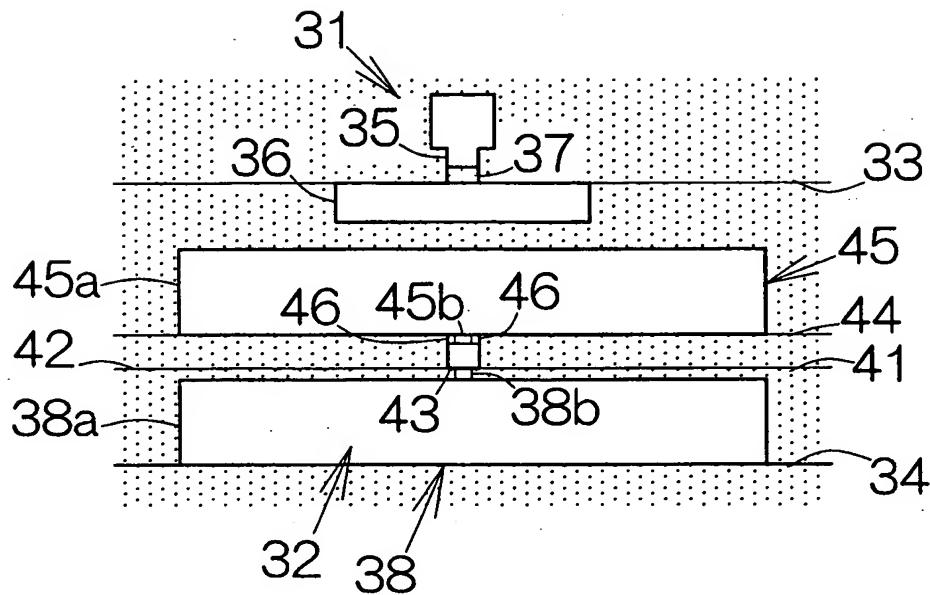
【図1】



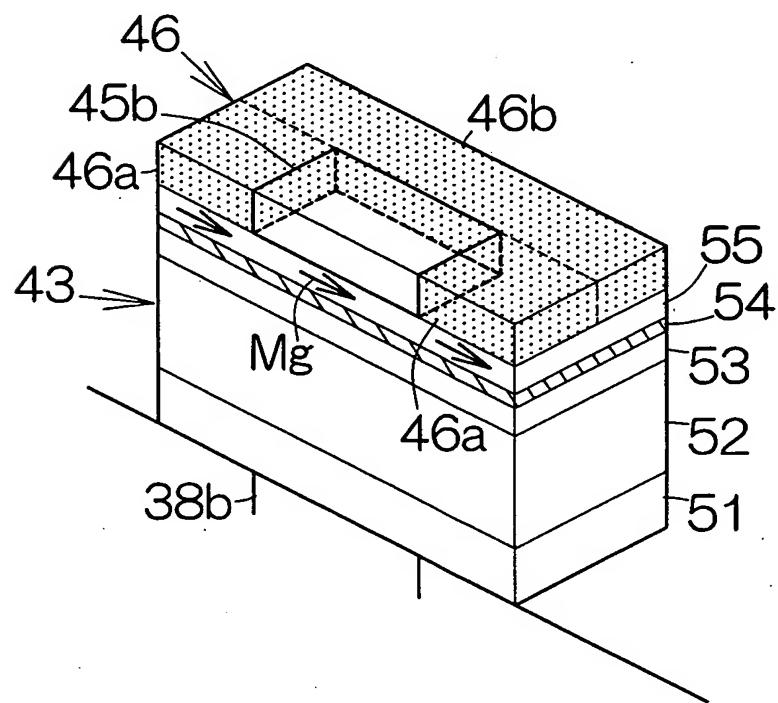
【図2】



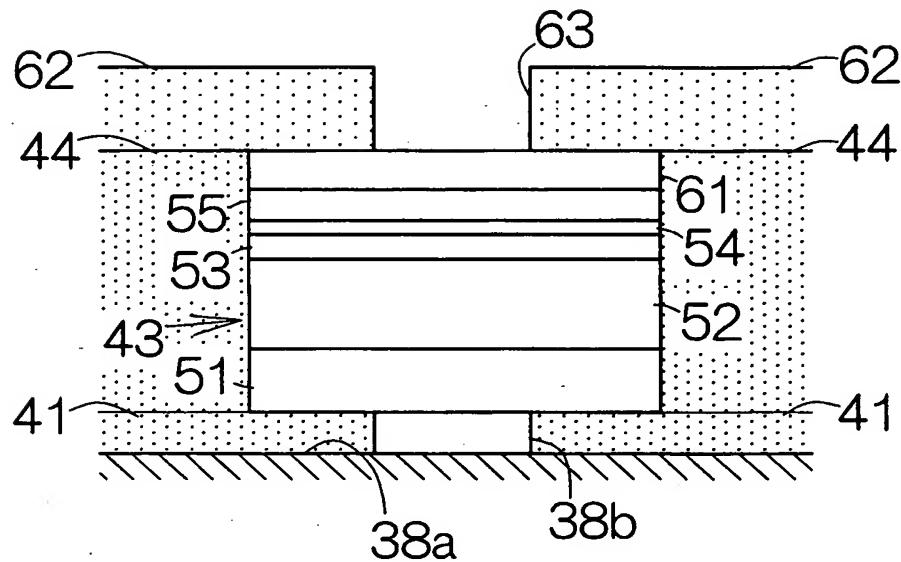
【図3】



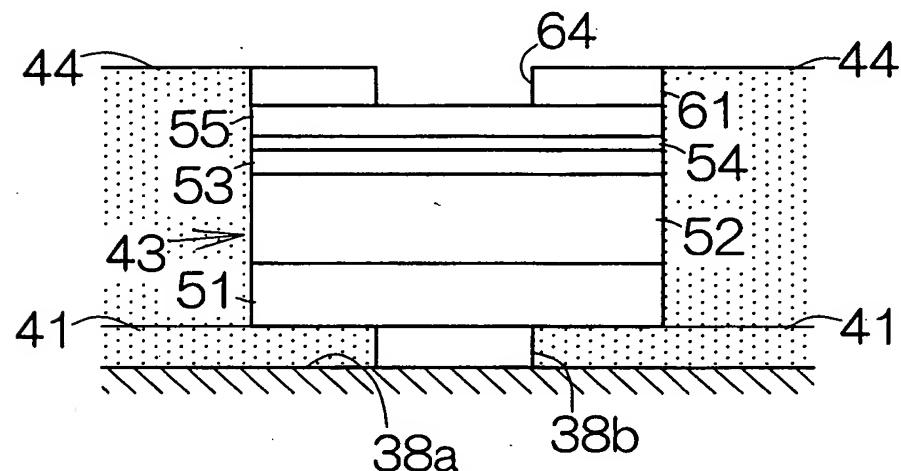
【図4】



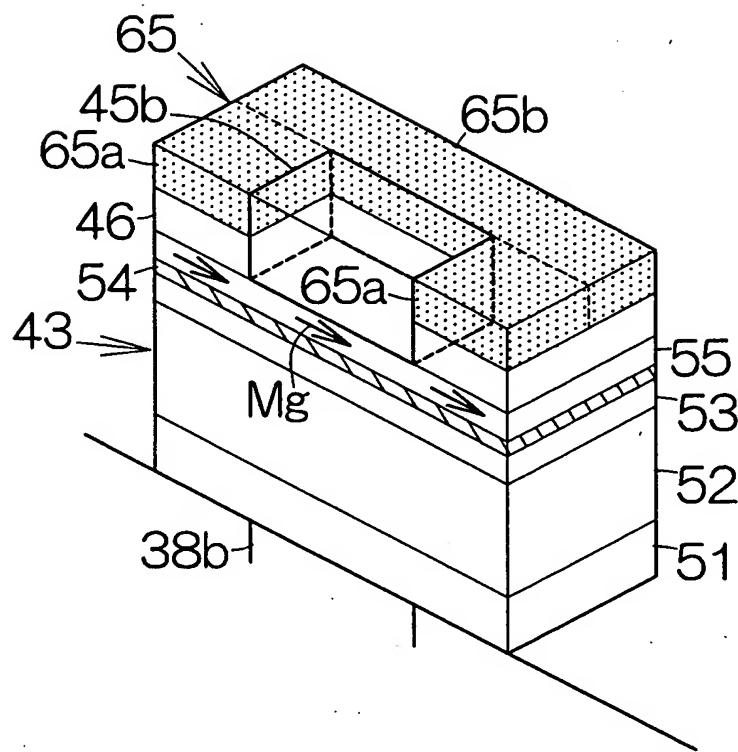
【図5】



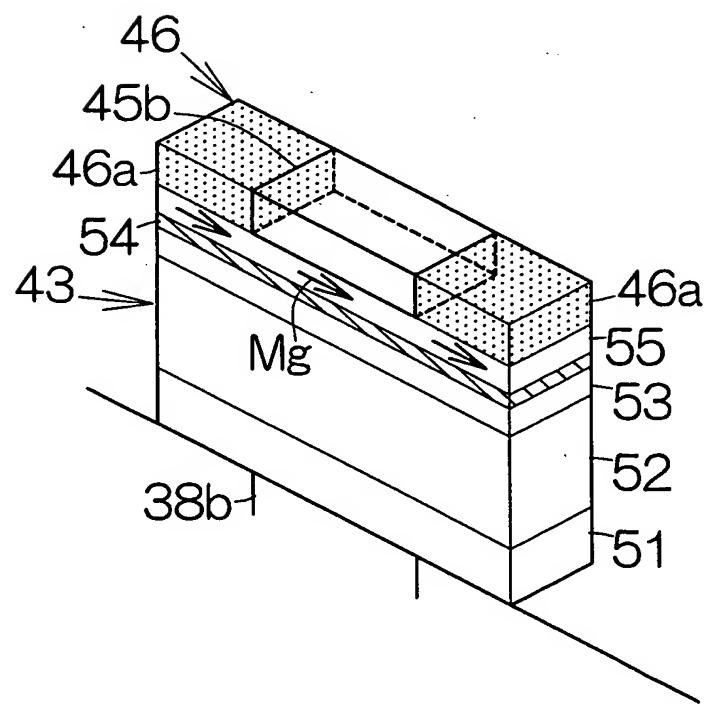
【図6】



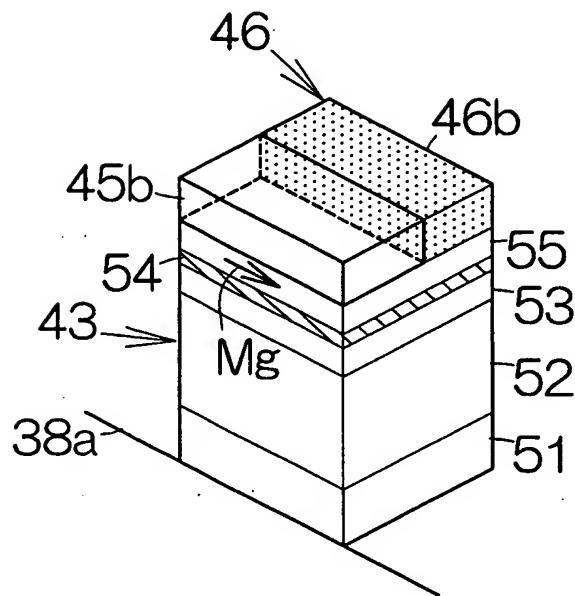
【図7】



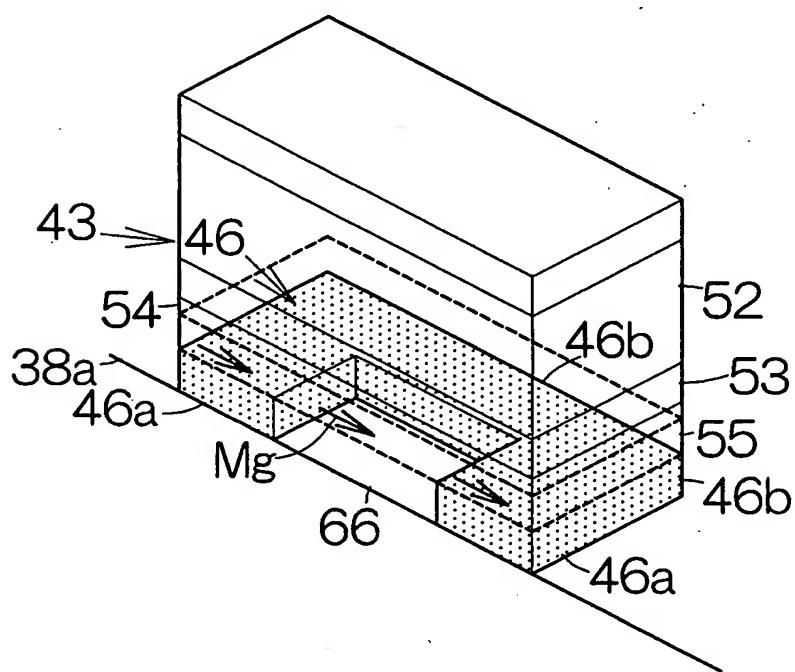
【図8】



【図9】



【図10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 一層の微細化を伴わずに十分に自由側磁性層の単磁区化を実現することができるC P P構造磁気抵抗効果素子を提供する。

【解決手段】 自由側磁性層55の表面には、上側電極の狭小電極層45bと、狭小電極層45bに隣接する磁区制御膜46とが形成される。磁区制御膜46には絶縁性が与えられる。磁区制御膜46および自由側磁性層55の交換結合に基づき自由側磁性層55の磁化方向は1方向に揃えられる。自由側磁性層55と上側電極との間では狭小電極層45bのみで電気的接続は確立される。自由側磁性層55や固定側磁性層53を流通する電流の流通路は狭められる。C P P構造磁気抵抗効果素子の読み取り感度は高められる。同時に実効コア幅は狭められる。

【選択図】 図4

出願人履歴情報

識別番号 [000005223]

1. 変更年月日 1996年 3月26日

[変更理由] 住所変更

住 所 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号
氏 名 富士通株式会社